01;07 К теории плазма-пучкового супергетеродинного лазера на свободных электронах с Н-убитронной накачкой

© В.В. Кулиш, А.В. Лысенко, В.В. Коваль

Национальный авиационный университет, Киев, Украина E-mail: kulish2001@ukr.net Сумской государственный университет, Сумы, Украина

Поступило в Редакцию 13 февраля 2009 г.

Произведен анализ плазма-пучкового супергетеродинного лазера на свободных электронах (ППСЛСЭ) с Н-убитронной накачкой. Изучено несколько вариантов реализации такого типа устройств. Часть из них соответствует устройствам с высокой степенью монохроматичности сигнала, тогда как другая — устройствам с достаточно широким спектром сигнала. Произведена оценка инкрементов нарастания волн в таких приборах. Выяснено, что при прочих равных ППСЛСЭ характеризуются существенно более высокими инкрементами, чем эквивалентные двухпотоковые супергетеродинные ЛСЭ. Показана перспективность практического использования предложенных приборов для генерации мощного электромагнитного излучения в миллиметровом диапазоне длин волн.

PACS: 41.60.Cr

Создание и разработка новых источников мощного электромагнитного излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов является одной из приоритетных задач плазменной релятивистской СВЧ-электроники на протяжени последних, по крайней мере, тридцати лет [1,2]. В процессе почти тридцатилетнего цикла исследований было выяснено [1], что использование эффекта супергетеродинного усиления волн в лазерах на свободных электронах (ЛСЭ) открывает уникальные возможности для создания такого рода источников, устройств, способных в том числе генерировать мощное и сверхмощное излучение при исключительно высоких уровнях усиления [1], формировать сверхмощные сигналы принципиально нового типа (фемтосекундные кластеры электромагнитной энергии тераваттного уровня [3]) и т.д.

25



Рис. 1. Схема плазма-пучкового супергетеродинного ЛСЭ.

Следует отметить, что, хотя именно плазма-пучковая версия супергетеродинного ЛСЭ (ППСЛСЭ) была исторически предложена первой [1], основное развитие "супергетеродинная" идея исторически получила в форме двухпотоковых супергетеродинных ЛСЭ (ДСЛСЭ) [1]. Вместе с тем проектный анализ систематически показывал, что практическая реализация ДСЛСЭ всегда осложнена рядом технологических проблем, возникающих в процессе разработки двухскоростного источника релятивистского сильноточного пучка. В связи с этим проблематика ППСЛСЭ снова стала актуальной, поскольку устройства данного типа лишены указанного рода недостатков.

Далее заметим, что в тех очень немногих работах, которые посвящены ППСЛСЭ, основное внимание традиционно уделялось лишь конструкционной схеме ППСЛСЭ с накачкой замедленной электромагнитной волной (допплертронная накачка) [1]. Тогда как базовой в техничке ЛСЭ считается накачка поперечным магнитоондуляторным полем (Н-убитронная накачка) [1].

В связи с вышесказанным основной целью данной работы является физический анализ устройств типа ППСЛСЭ с Н-убитронной накачкой. Проведенные исследования позволили сделать вывод, что использование предложенных здесь схем может открыть новые многообещающие перспективы в области техники супергетеродинных ЛСЭ.

Модель плазма-пучкового супергетеродинного лазера на свободных электронах с Н-убитронной накачкой представлена на рис. 1. Электронный релятивистский пучок 1 с ленгмюровской частотой ω_b проходит через плазму 2, в свою очередь, характеризующуюся ленгмюровской частотой ω_p . Плазма-пучковая система размещена в продольном фоку-

сирующем магнитном поле с напряженностью H_0 . В качестве накачки используем спиральный магнитный ондулятор 3, который характеризуется периодом ондуляции $\Lambda = 2\pi/k_2$ и напряженностью магнитного поля H_2 . На вход системы также подаем электромагнитный сигнал с частотой ω_1 и волновым числом k_1 . Волна пространственного заряда (ВПЗ) с частотой ω_3 и волновым числом k_3 возбуждается в плазмапучковой системе в результате нелинейного характера взаимодействия волн сигнала { ω_1, k_1 } и ондулятора { k_2 }. Считаем, что для частот и волновых чисел этих волн выполняется условие параметрического резонанса

$$\omega_3 = \omega_1, \qquad k_3 = k_1 + k_2.$$
 (1)

При этом параметры системы выбираем таким образом, чтобы волна ВПЗ $\{\omega_3, k_3\}$ характеризовалась максимальным инкрементом нарастания вследствие реализации плазма-пучковой неустойчивости.

При выполнении (1) в системе реализуется параметрический механизм усиления волны сигнала [1]. Основное отличие "обычных" (параметрических) ЛСЭ от супергетеродинных состоит в том, что для ВПЗ здесь введено дополнительное усиление. В силу отмеченной выше нелинейной связи волн это усиление переносится на волну сигнала $\{\omega_1, k_1\}$.

Рассмотрим линейную стадию усиления волн в исследуемой плазмапучковой системе с продольным фокусирующим полем. Дисперсионные уравнения для электромагнитной волны сигнала { ω_1 , k_1 } и волны ВПЗ { ω_3 , k_3 } в данном случае имеют вид (см., например, [1,2]):

$$k_1^2 c^2 - \omega_1^2 + \frac{\omega_p^2 \omega_1}{(\omega_1 - \eta \omega_H)} + \frac{\omega_b^2 (\omega_1 - k_1 v_b)}{\gamma_b (\omega_1 - k_1 v_b - \eta \omega_H / \gamma_b)} = 0, \qquad (2)$$

$$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega_3^2} - \frac{\omega_b^2}{(\omega_3 - k_3 v_b)^2 \gamma_b^3} = 0.$$
(3)

В этих уравнениях $\omega_H = eH_0/(m_ec)$ — циклотронная частота вращения электронов плазмы в продольном магнитном поле; c — скорость света; v_b , γ_b — скорость и релятивистский фактор электронов пучка; $\eta = \pm 1$ —знаковая функция, которая характеризует направление вращения вектора напряженности электрического поля циркулярно поляризованной волны сигнала.



Рис. 2. Дисперсионные кривые волн ВПЗ электромагнитного сигнала в плазмапучковом супергетеродинном ЛСЭ с Н-убитронной накачкой. Параметры системы, при которых были проведены расчеты, представлены в таблице.

Для исследования особенностей резонансного взаимодействия волн в рассматриваемом плазма-пучковом ЛСЭ построим зависимости (рис. 2) частоты волны сигнала и ВПЗ от волнового числа, используя формулы (2), (3). На этом рисунке сплошная линия соответствует зависимости $\omega = \omega(k)$ для волн ВПЗ, штриховые — для электромагнитных волн. Кривая 1 соответствует обыкновенной, кривая 2 — необыкновенной электромагнитным волнам [2], кривые 3 и 4 соответствуют лево-и правополяризованным электромагнитным волнам, в распространении которых существенную роль играют электроны пучка.

Как уже упоминалось выше, волновое число k_3 и частоту ω_3 волны ВПЗ выбираем таким образом, чтобы волна ВПЗ имела максимальный инкремент нарастания вследствие плазма-пучковой неустойчивости. Этому условию, как известно (см., например, [2]), соответствует значение волнового числа $k_3 = \omega_p/v_b$. Такому значению волнового числа k_3 и частоты ω_3 соответствует точка O дисперсионной кривой ВПЗ (см. рис. 2). В соответствии с условием параметрического резонанса (1) частоты волны ВПЗ и электромагнитного сигнала должны быть одинаковыми $\omega_1 = \omega_3$. Проведем через точку O горизонтальную

29

Параметры исследуемой системы

Параметр	Значение
Ленгмюровская частота плазмы (ω_p)	$1.0\cdot 10^{12}s^{-1}$
Ленгмюровская частота пучка (ω_b)	$2.0 \cdot 10^9 s^{-1}$
Значение релятивистского фактора пучка (γ_b)	2.0
Напряженность продольного магнитного поля (H ₀)	$2.8 \cdot 10^3$ Oe

линию $\omega = \omega_3 = \text{const}$ (штрихпунктирная линия *AD*). Точки *A*, *B*, *C*, *D*, которые получаются в результате пересечения прямой *AD* с дисперсными кривыми электромагнитных волн, характеризуют частоты и волновые числа электромагнитных волн, которые могут принимать участие в параметрически-резонансном взаимодействии волн в исследуемой системе. Таким образом, в рассматриваемом ППСЛСЭ может быть реализовано четыре типа резонансных волновых взаимодействий, которые обозначим *A*, *B*, *C*, *D* в соответствии с точками *A*, *B*, *C*, *D* на рис. 2. Эти точки характеризуют частоты и волновые числа электромагнитных волн, участвующих в параметрическом резонансе. Проведем анализ таких взаимодействий волн более детально.

Рассмотрим систему, параметры которой представлены в таблице. В этом случае длина волны сигнала в вакууме будет равна 1.8 mm. Решая систему уравнений (1)–(3), нетрудно найти для каждого типа параметрического резонанса период ондулятора: $\Lambda_A = 7.47$ cm, $\Lambda_B = 5.79$ cm, $\Lambda_C = 0.20$ cm, $\Lambda_D = 0.14$ cm (индекс соответствует типу параметрического резонанса). Как видим, наиболее интересными с точки зрения практической реализации прибора являются случаи *A* и *B*. Выясним, какие параметры системы определяют период ондулятора в случаях *A* и *B*. Как уже говорилось выше, кривые *3* и *4* соответствуют электромагнитным волнам, в распространении которых существенную роль играют электроны пучка. С математической точки зрения эти волны в уравнении (2) определяются третьим слагаемым. Оно становится существенным, когда знаменатель этого слагаемого становится близким к нулю

$$\omega_1 - k_1 v_b - \eta \omega_H / \gamma_b \approx 0. \tag{4}$$

Для волны ВПЗ выполняется следующее приближенное равенство:

$$k_3 = \frac{\omega_p}{v_b} \approx \frac{\omega_3}{v_b}.$$
 (5)

Учитывая условия параметрического резонанса (1), несложно найти параметры ондулятора:

$$k_2 = k_3 - k_1 \approx \frac{\omega_3}{\upsilon_b} - \frac{\omega_1}{\upsilon_b} + \frac{\eta\omega_H}{\gamma_b} = \frac{\eta\omega_H}{\gamma_b}.$$
 (6)

Отсюда следует, что волновое число ондулятора в случаях A и B определяется величиной индукции магнитного поля $\omega_H = eH_0/(m_ec) \sim H_0$, релятивистским фактором пучка (γ_b) и поляризацией циркулярно поляризованной электромагнитной волны сигнала (η) . Таким образом, напряженность продольного фокусирующего магнитного поля является определяющим фактором для периода ондуляции H-убитронного магнитного поля системы.

Еще одной особенностью параметрического резонанса волн в рассматриваемой системе, которая следует из формулы (2), является то, что волновое число k_2 не зависит от частоты волн сигнала и ВПЗ. К этому же выводу можно прийти, анализируя рис. 2. Здесь кривые 3, 4 и соответствующие кривые ВПЗ являются практически параллельными, что свидетельствует о том, что "расстояние" между ними для различных частот остается практически неизменным. Из этого следует, что условие параметрической связи будет выполняться не только для основных гармоник волн сигнала и ВПЗ, но и для высших гармоник. То есть в случае реализации параметрических резонансов A и *В* могут иметь место мультигармонические взаимодействия, генерация высших гармоник. Это открывает новые возможности формирования электромагнитных сигналов со сложным мультигармоническим спектром [3].

Для параметрических резонансов C и D, как следует из приведенных выше оценок ($\Lambda_C = 0.20$ cm; $\Lambda_D = 0.14$ cm), необходимо использовать микроондуляторы. Анализируя кривые 1 и 2 на рис. 2, можно сделать вывод, что в случае C и D будут реализовываться монохроматические режимы работы.

Далее следует отметить, что во всех рассматриваемых случаях инкремент нарастания, связанный с плазма-пучковой неустойчивостью,

существенно больше инкремента, который определяется параметрическим резонансом волн. Поэтому во всех четырех параметрическирезонансных взаимодействиях нарастание волн в исследуемом приборе будет определяться именно инкрементом нарастания плазма-пучковой неустойчивости [2]

$$\alpha_1 \approx \frac{\sqrt{3}\,\omega_b^{2/3}\omega_p^{1/3}}{\sqrt[3]{16}\,\gamma_b}.\tag{7}$$

Ближайшим физическим аналогом исследуемого явления, как отмечалось выше, является эффект супергетеродинного усиления в двухпотоковых супергетеродинных лазерах на свободных электронах [1]. Для иллюстрации преимущества плазма-пучкового ЛСЭ по отношению к двухпотоковому супергетеродинному ЛСЭ проведем сравнение полученного инкремента нарастания α_1 с максимальным инкрементом нарастания эквивалентной двухпотоковой системы α_2 [1]

$$\alpha_2 = \frac{\omega_b}{2\gamma_b^{3/2}}.\tag{8}$$

Под эквивалентной двухпотоковой системой в этом случае понимаем систему, в которой парциальный электронный пучок имеет такие же параметры, как и пучок в случае плазма-пучковой системы.

Анализируя соотношения (7) и (8), можем сделать вывод, что инкремент нарастания плазма-пучковой системы α_1 существенно больше инкремента нарастания эквивалентной двухпотоковой системы α_2 . Это связано с тем, что, во-первых, инкремент плазма-пучковой системы $\alpha_1 \sim (\omega_p)^{1/3} (\omega_b)^{2/3}$, тогда как $\alpha_2 \sim \omega_b$. Благодаря тому что ленгмюровская частота плазмы ω_p в реальных приборах может быть намного больше ленгмюровской частоты пучка ω_b , инкремент α_1 существенно больше α_2 . Во-вторых, зависимость инкрементов нарастания от релятивистских факторов является разной: $\alpha_1 \sim 1/(\gamma_b)$, $\alpha_2 \sim 1/(\gamma_b)^{3/2}$. Это означает, что релятивизм пучка в случае плазма-пучковой системы слабее уменьшает инкремент нарастания, чем в случае двухпотоковой системы.

Для иллюстрации вышесказанного проведем численные оценки. Для параметров, которые представлены в таблице, получим, используя соотношение (7) и (8), что $\alpha_1 = 5.46 \cdot 10^9 \, {\rm s}^{-1}$, $\alpha_2 = 0.35 \cdot 10^9 \, {\rm s}^{-1}$. Таким образом, инкремент нарастания в исследуемой системе намного выше

(а именно, более чем в десять раз!), чем в случае эквивалентной двухпотоковой системы. Отсюда следует уникальная возможность создания мощных устройств миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн.

Таким образом, в работе рассмотрена схема плазма-пучкового супергетеродинного ЛСЭ с Н-убитронной накачкой, работающего в миллиметровой области длин волн. Рассмотрен ряд режимов работы такого устройства. Одни режимы позволяют усиливать сигналы, обладающие высокой степенью монохроматичности. Другие режимы позволяют формировать сигнал с достаточно широким спектром сигнала. Проведена оценка инкрементов нарастания волн в таких приборах. Выяснено, что исследуемые системы имеют существенно большие инкременты нарастания, чем эквивалентные двухпотоковые. Показана перспективнось использования данных приборов для генерации мощного электромагнитного излучения в миллиметровом диапазоне, для создания мультигармонических систем.

Список литературы

- [1] *Kulish V.V.* Hierarchical methods. Vol. II. Undulative electrodynamic systems. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2002.
- [2] Кузелев М.В., Рухадзе А.А., Стрелков П.С. Плазменная релятивистская СВЧ-электроника. М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2002.
- [3] Kulish V.V., Lysenko O.V., Savchenko V.I., Majornikov I.G. // Laser Physics. 2005.
 V. 15. N 12. P. 1629–1633.